Дисциплина "Основы электроники" **Лабораторная работа №**4

Исследование характеристик и параметров полупроводниковых диодов.

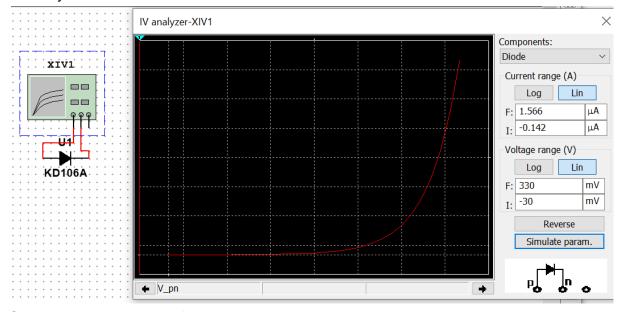
Работу выполнила: Ляпина Н.В. группа ИУ7-32Б вариант №12

Работу проверил:

Цель работы: Получение и исследование статических и динамических характеристик германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобрести навыки в использовании базовых возможностей программ схемотехнического анализа, на примере программы Multisim, для исследования статических и динамических характеристик полупроводниковых диодов с последующим расчетом параметров модели полупроводникового диода. Приобретение навыков расчета моделей полупроводниковых приборов по данным, полученным в экспериментальных исследованиях и включение модели в базу компонентов.

Эксперимент 5

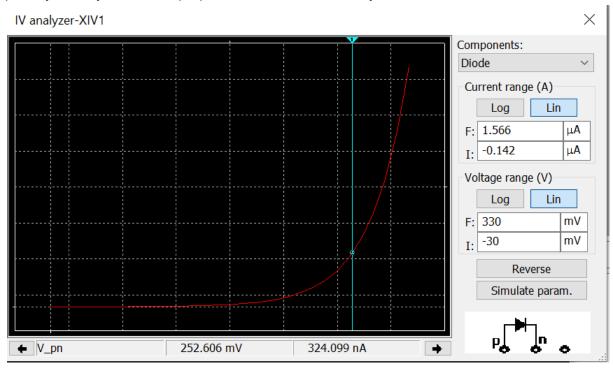
Схема установки



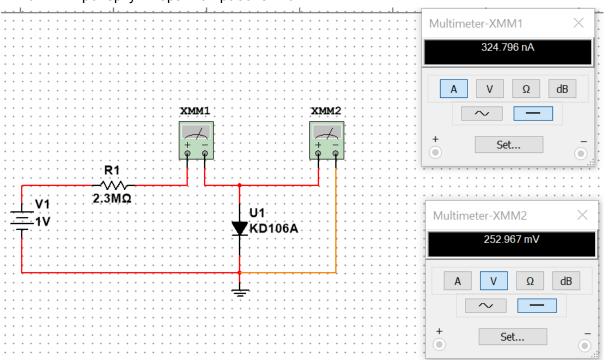
Экспортируем данные в файл

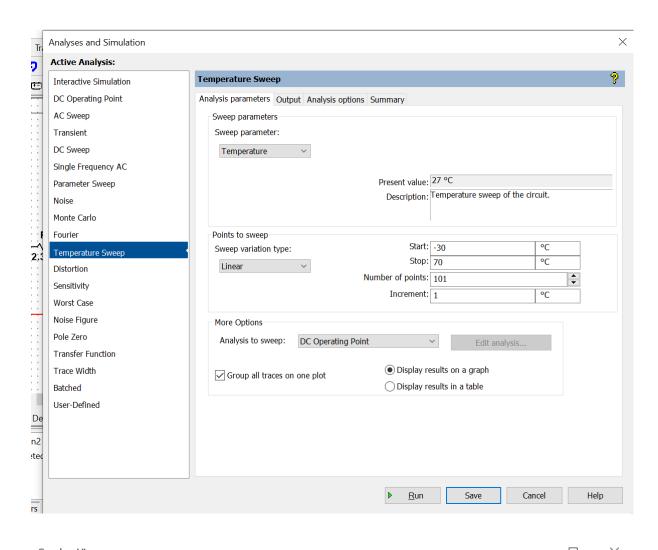
```
X_Unit_Label
                     V) (V_pn
ΧØ
        0.000000e+000
Delta X
            1.000000e-002
***End_of_Header***
X_Value_1
            Trace_1(V_pn)
                             Comment
                -1.085467e-036
0.000000e+000
                4.224687e-011
1.000000e-002
2.000000e-002
                1.000867e-010
3.000000e-002
               1.792786e-010
4.000000e-002
                2.877091e-010
5.000000e-002
                4.361775e-010
6.000000e-002
                6.394720e-010
7.000000e-002
                9.178425e-010
8.000000e-002
                1.299018e-009
9.000000e-002
                1.820971e-009
1.000000e-001
                2.535697e-009
1.100000e-001
                3.514397e-009
1.200000e-001
                4.854571e-009
1.300000e-001
                6.689729e-009
1.400000e-001
                9.202694e-009
1.500000e-001
                1.264382e-008
```

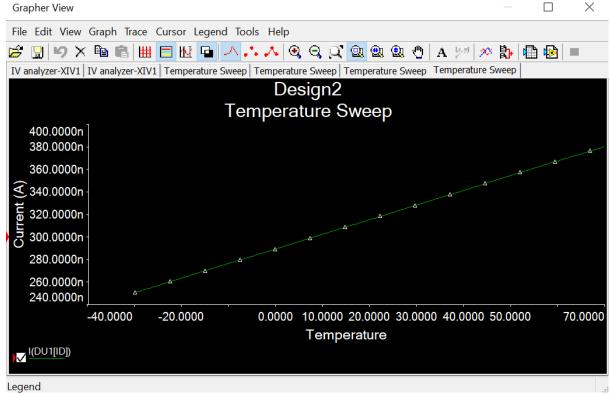
Исследуем ВАХ в диапазоне температур до -30 до 70 градусов Цельсия. Для начала рассчитаем R1, которое обеспечивает работу диода. Для этого выберем произвольную рабочую точку диода на графике BAX, снятом IV analyzer.

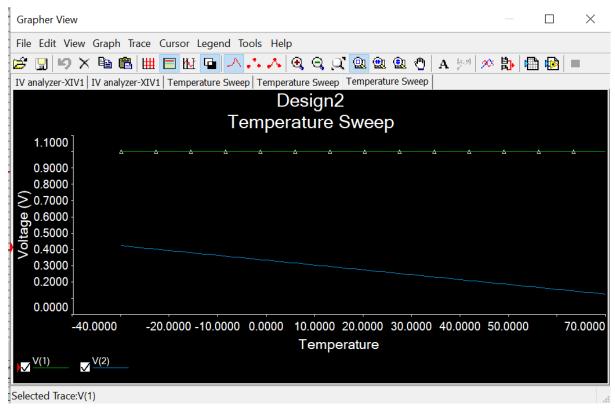


Сопротивление при источнике 1 Вольт : R = 2,3 МОм Выполним проверку выбранной рабочей точки





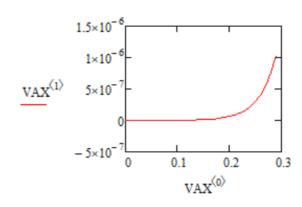




Теперь построим BAX в Mathcad, рассчитаем параметры модели и сравним две BAX (исходную и модельную)

 $VAX := READPRN("C:\MC12\lab_04.txt")$

		0	1
VAX =	0	0	0
	1	0.01	4.225 • 10 - 11
	2	0.02	1.001.10-10
	3	0.03	1.793·10-10
	4	0.04	2.877·10-10
	5	0.05	4.362·10-10
	6	0.06	6.395·10 ⁻¹⁰
	7	0.07	9.178·10 ⁻¹⁰
	8	0.08	1.299·10 ⁻⁹
	9	0.09	1.821·10 ⁻⁹
	10	0.1	2.536·10 ⁻⁹
	11	0.11	3.514·10 ⁻⁹
	12	0.12	4.855·10 ⁻⁹
	13	0.13	6.69·10 ⁻⁹
	14	0.14	9.203·10 ⁻⁹
	15	0.15	



Трассировкой выбраны 4 точки и рассчитаны приближения

Метод GIVEN MINERR

Начальное приблежение

$$Rb := 1$$
 $Is0 := 0.0000001$ $m := 2$

$$m := 2$$

$$Ft := 0.02$$

Given

$$Ud4 = Id4 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Is0 + Id4)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud1 = Id1 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Is0 + Id1)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud2 = Id2 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Is0 + Id2)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud3 = Id3 \cdot Rb + ln \left[\frac{(Is0 + Id3)}{Is0} \right] \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud1 := 0.14$$
 $Id1 := 9.202694e-009$

$$Ud2 := 0.19$$
 $Id2 := 4.474337e-008$

Rb :=
$$\frac{(Ud1 - 2 \cdot Ud2 + Ud3)}{Id1} = 0$$

NFt :=
$$\frac{[(3Ud2 - 2Ud1) - Ud3]}{ln(2)} = 0.072$$

Is0 := Id1 · exp
$$\left[\frac{(Ud2 - 2Ud1)}{NFt}\right]$$
 = 2.643 × 10⁻⁹

 $Diod_P := Minerr(Is0, Rb, m, Ft)$

Diod_P =
$$\begin{pmatrix} 1.143 \times 10^{-10} \\ -1.87 \\ 1.669 \\ 0.019 \end{pmatrix}$$

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ВАХ МОДЕЛИ И ИСХОДНЫХ ТАБЛИЧНЫх ДАННЫХ:

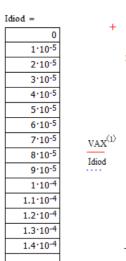
данные расчета

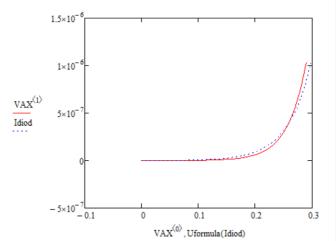
$$Rb1 := 1.143 \times 10^{-10} \quad NFt1 := 0.015 \cdot 2.727 \qquad Is01 := 7.005 \cdot 10^{-10}$$

Idiod := $VAX^{\langle 1 \rangle}$

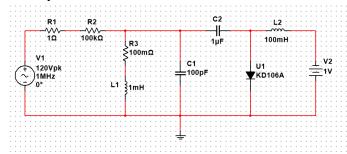
Idiod := 0.10^{-5} ... 0.023

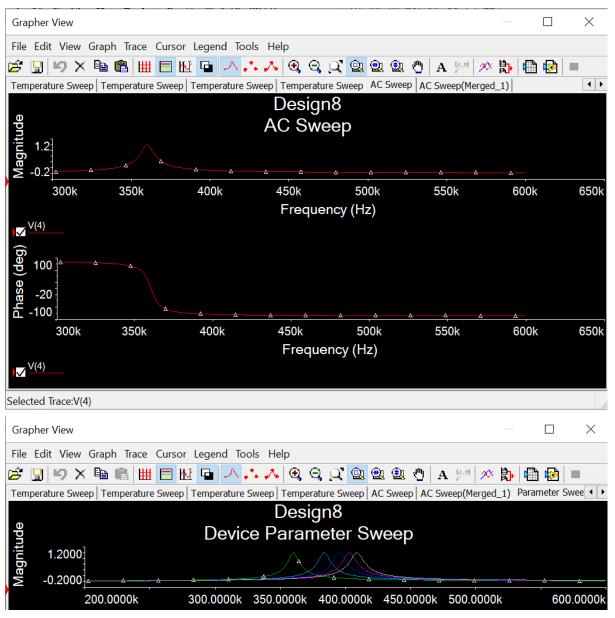






Эксперимент 6





Вручную выписываем пики в Mathcad и производим расчёт параметров диода

Fmax :=
$$\begin{pmatrix} 360160 \\ 383784 \\ 395395 \\ 403003 \\ 408608 \end{pmatrix}$$
Vvar :=
$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3.25 \\ -5.5 \\ -7.75 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$$\frac{4.1 \times 10^{5}}{4 \times 10^{5}}$$

$$\frac{4 \times 10^{5}}{3.9 \times 10^{5}}$$

$$\frac{5}{3.6 \times 10^{5}}$$

$$\frac{3.6 \times 10^{5}}{10 - 8 - 6 - 4 - 2}$$
Vvar

$$Lk := 10^{-3} \hspace{1cm} Ck := 10^{-10} \hspace{1cm} pi := 3.14 \hspace{1cm} Fr := Fmax$$

$$Cd := \frac{-\left(Ck \cdot Lk - \frac{1}{4 \cdot Fr^2 \cdot pi^2}\right)}{Ik}$$

$$M := 0.33$$
 $Cj0 := 130 \cdot 10^{-12}$ $Vj0 := 0.71$

$$Cd = \begin{pmatrix} 9.547 \times 10^{-11} \\ 7.215 \times 10^{-11} \\ 6.219 \times 10^{-11} \\ 5.612 \times 10^{-11} \\ 5.187 \times 10^{-11} \end{pmatrix} Vvar = \begin{pmatrix} -1 \\ -3.25 \\ -5.5 \\ -7.75 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Given

$$5.187 \times 10^{-11} = \text{Cj0} \cdot \left(1 - \frac{-10}{\text{Vj0}}\right)^{-\text{M}}$$

$$5.612 \times 10^{-11} = \text{Cj0} \cdot \left(1 - \frac{-7.75}{\text{Vj0}}\right)^{-\text{M}}$$

$$6.219 \times 10^{-11} = \text{Cj0} \cdot \left(1 - \frac{-5.5}{\text{Vj0}}\right)^{-\text{M}}$$

$$7.215 \times 10^{-11} = \text{Cj0} \cdot \left(1 - \frac{-3.25}{\text{Vj0}}\right)^{-\text{M}}$$

$$Diod_P := Minerr(Cj0, Vj0, M)$$

$$Diod_P = \begin{pmatrix} 1.239 \times 10^{-10} \\ 0.819 \\ 0.337 \end{pmatrix}$$

Полученные параметры

$$Cj1 := 1.239 \times 10^{-10} \qquad Vj1 := 0.819 \qquad \qquad M1 := 0.337$$

$$\text{Cd1}(U) \coloneqq \text{Cj1} \cdot \left(1 - \frac{U}{Vj1}\right)^{-M1}$$

Параметры из библиотеки

$$Cj0 = 1.3 \times 10^{-10}$$
 $Vj0 = 0.71$ $M = 0.33$

$$\label{eq:Cdmain} \text{Cdmain}(U) := Cj0 \cdot \left(1 - \frac{U}{Vj0}\right)^{-} M$$

